



行业动态  
Industry News



- ▣ 科普首页
- ▣ 微电子历史
- ▣ 行业动态
- ▣ 术语解释
- ▣ 无微不至
- ▣ 芯片制程
- ▣ 科普创意

### Vishay新型TrenchFET? 功率MOSFET实现业内最低导通电阻

2009-01-06 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

日前, Vishay Intertechnology, Inc.日前宣布推出新型 20-V 和 30-V p-通道 TrenchFET® 功率 MOSFET --- Si7633DP和Si7135DP。这次推出的器件采用 SO-8 封装, 具有 ±20-V 栅源极电压以及业内最低的导通电阻。

现有的同类 SO-8 封装器件额定电压下导通电阻仅低至 24 mΩ, 而Vishay 的 Si7633DP 具有 3.3 mΩ (在 10 V 时) 及 5.5 mΩ (在4.5 V 时) 的超低导通电阻。这些值比最接近的同类 30-V 器件低 27% (在 10 V 时) 和 28% (在4.5 V 时), 比最接近的同类 25-V SO-8 器件分别低 28% 和 15%。30-V Si7135DP 的导通电阻为 3.9 mΩ (在 10 V 时) 和 6.2 mΩ (在4.5 V 时), 比最接近的同类器件分别低 13% (在 10 V 时) 和 19.5% (在4.5 V 时)。

这次推出的两款 MOSFET均采用PowerPAK® SO-8 封装, 可容许比其它 SO-8 封装器件高 60% 的最大漏电流和高 75 % 的最大功率损耗。

这两款新型器件可用作适配器切换开关, 用于笔记本电脑及工业/通用系统中的负载切换应用。适配器切换开关 (在适配器/墙壁电源和电池电源间切换) 一直处于导通状态, 消耗电流。Si7633DP 和Si7135DP的低导通电阻能耗低, 节省电力并延长两次充电间的电池可用时间。

Vishay 还推出了采用 SO-8 封装的 Si4459ADY 30-V p-通道 TrenchFET 功率 MOSFET。该器件具有 5 mΩ (在 10 V 时) 和 7.75 mΩ (在4.5 V 时) 的导通电阻。此次推出的所有器件 100% 通过 Rg 和 UIS 认证, 且不含卤素。

目前, 该新型Si7633DP和Si7135DP TrenchFET 功率 MOSFET可提供样品, 并已实现量产, 大宗订单的供货周期为 10 至 12 周。

(来源: 半导体国际 2008年12月23日)